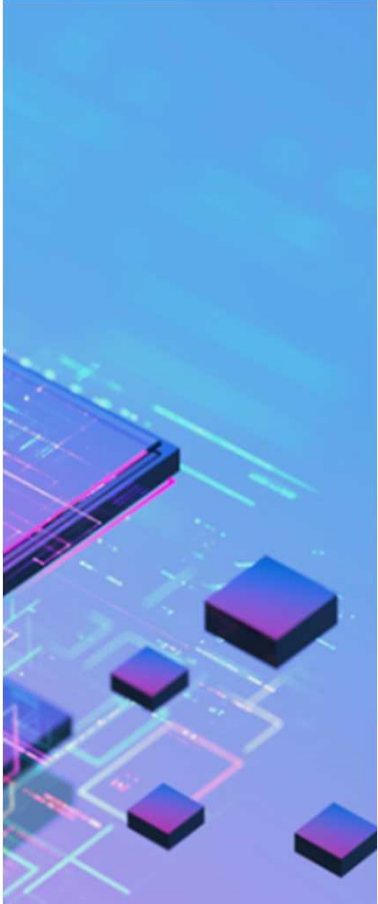


株式会社 アルバック

2025年6月期 第2四半期 決算説明資料

2024年7月～2024年12月

2025年2月12日



将来見通し等に関する記述についての注意事項

■ 将来見通しについて

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

■ 数字の処理について

本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。

■ 品目名称変更について

2025年6月期より、FPD製造装置の名称をディスプレイ・エネルギー関連製造装置に変更しております。

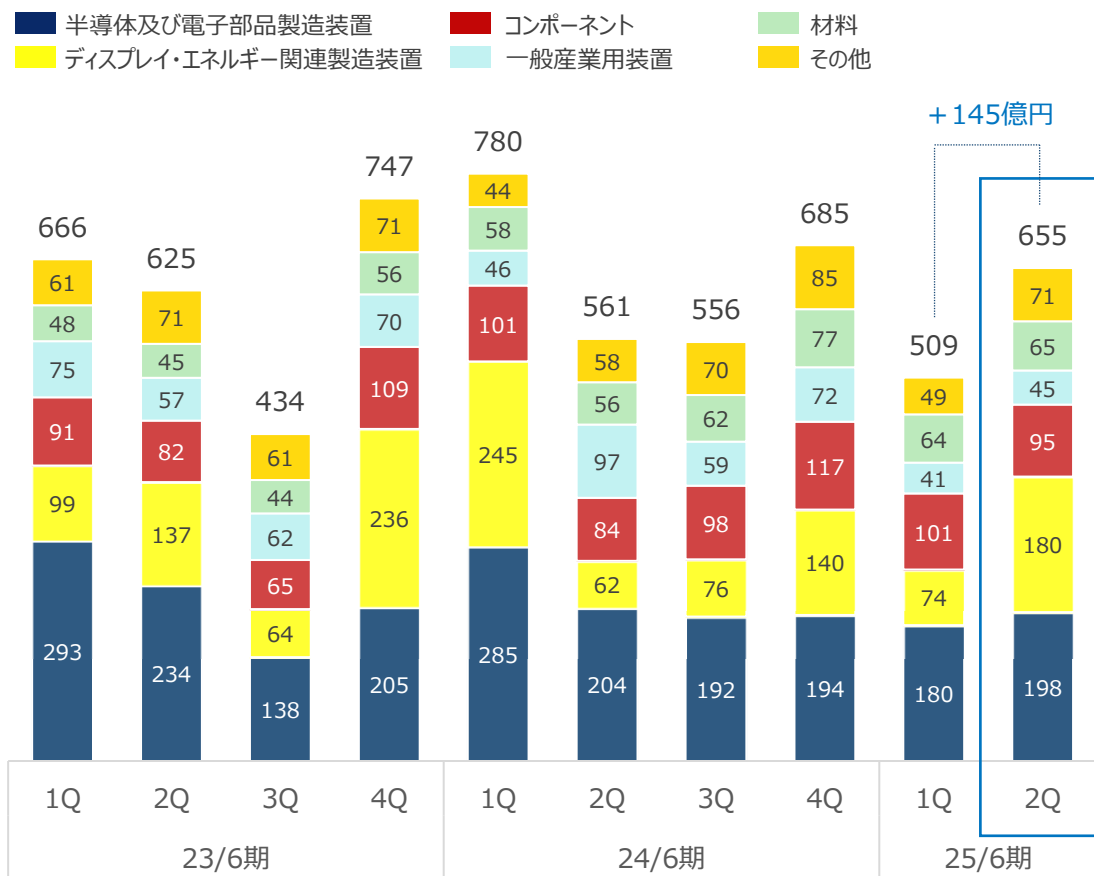
- 上期の売上高・各利益項目は、計画比・前年同期比を上回る増収増益で着地
受注高は前年同期比で減少も、下期は上期比増加を見込む
- 利益率のベースが着実に上昇、2Q売上総利益 238億円は四半期ベースで
上場来最高水準
- 通期受注高を見直すも、売上高・各利益項目の連結業績予想に変更なし
⇒ 市場環境・投資動向トレンドを確実に捉え、全体の受注拡大を目指す

【単位：億円】	2024/6期						2025/6期					
	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	上期計画	上期実績	前年同期比	
受注高	780	561	1,340	556	685	2,582	509	655	1,340	1,164	-176	-13%
売上高	550	652	1,202	650	759	2,611	610	739	1,290	1,349	+147	+12%
売上総利益	153	201	354	220	233	807	191	238	-	429	+75	+21%
率	27.7%	30.8%	29.4%	33.8%	30.7%	30.9%	31.3%	32.2%	-	31.8%	+2.4pt	
販管費	124	126	250	119	139	509	134	142	-	276	+26	+10%
営業利益	28	75	103	101	94	298	58	96	140	153	+50	+49%
率	5.1%	11.5%	8.6%	15.5%	12.3%	11.4%	9.4%	13.0%	10.9%	11.4%	+2.8pt	
経常利益	29	81	110	95	93	298	69	92	140	161	+51	+46%
率	5.3%	12.4%	9.1%	14.6%	12.3%	11.4%	11.3%	12.4%	10.9%	11.9%	+2.8pt	
親会社株主に帰属する 当期純利益	11	57	69	64	69	202	37	67	90	104	+35	+51%
率	2.1%	8.8%	5.7%	9.9%	9.1%	7.7%	6.1%	9.0%	7.0%	7.7%	+2.0pt	

- ≫ YoY増収増益を達成、売上総利益率は 31.8% と着実に上昇
- ≫ 1Q比で2Qは全ての項目で改善

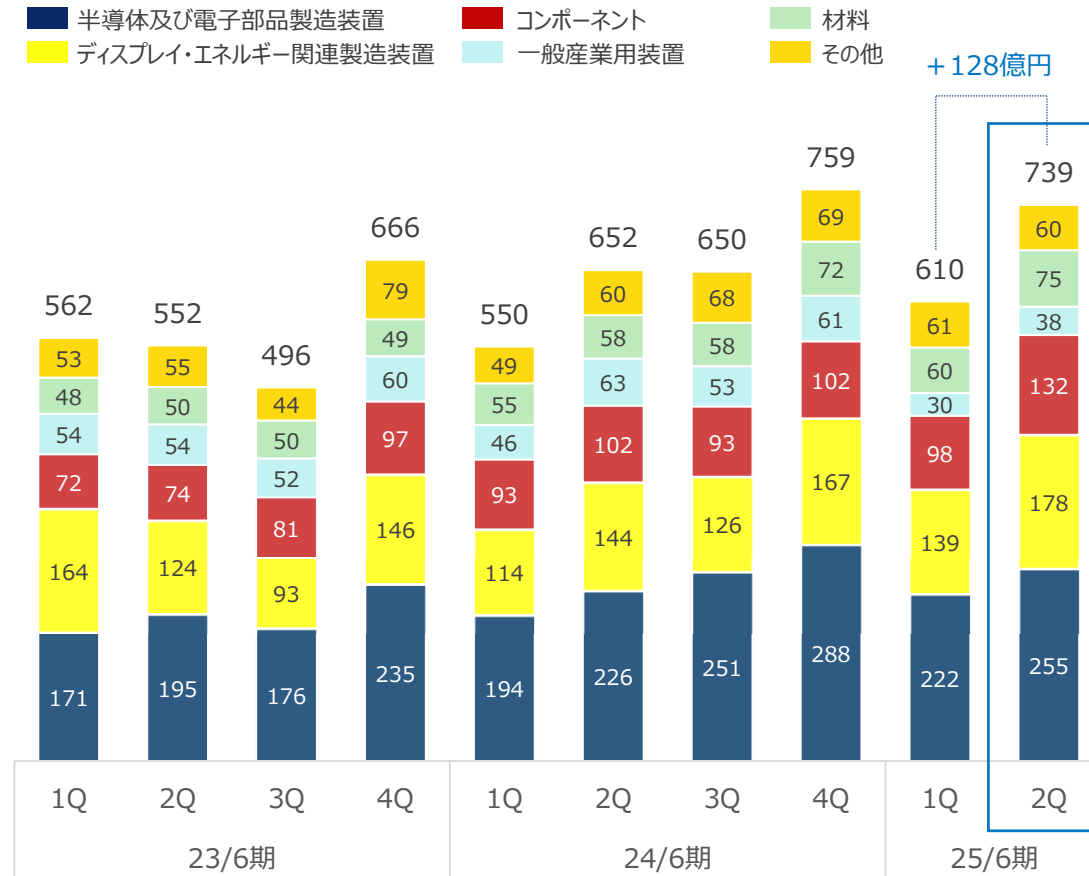
受注高

【単位：億円】



売上高

【単位：億円】



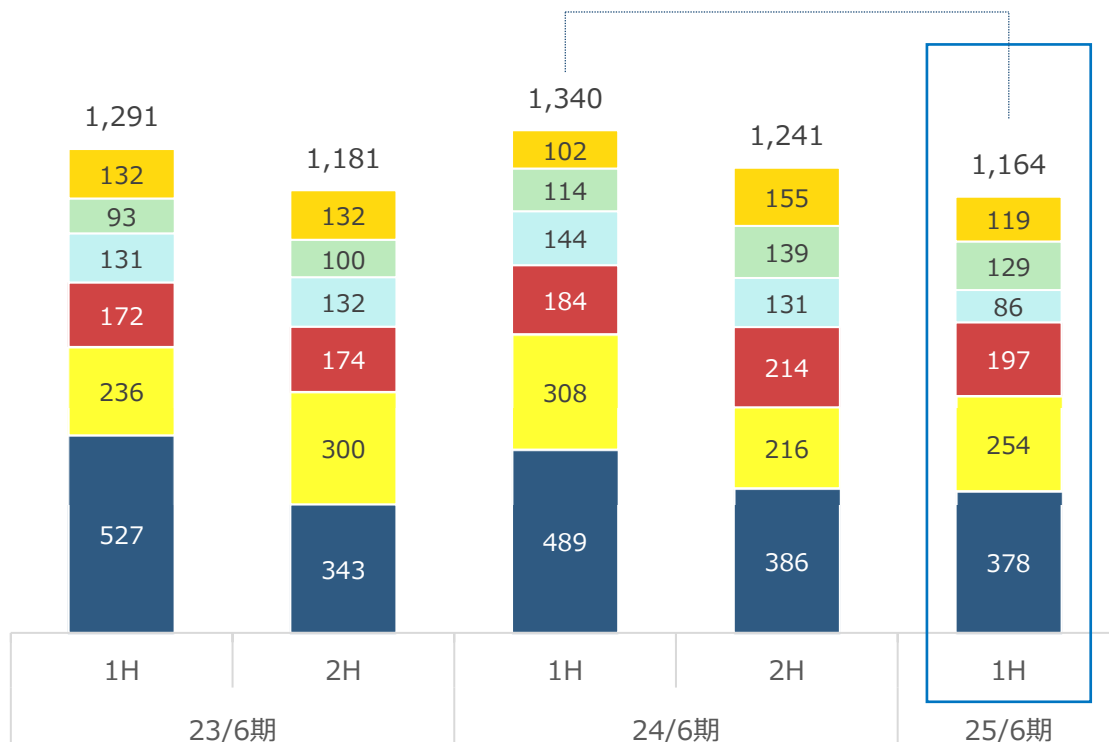
- ≫ **【受注高】 1Q比+145億円：OLED（G8.7）案件受注、その他（表面分析装置）等が増加**
- ≫ **【売上高】 1Q比+128億円：高水準の受注残高が寄与し、総じて品目毎に増加**

受注高

【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ 材料
■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他

▲176億円

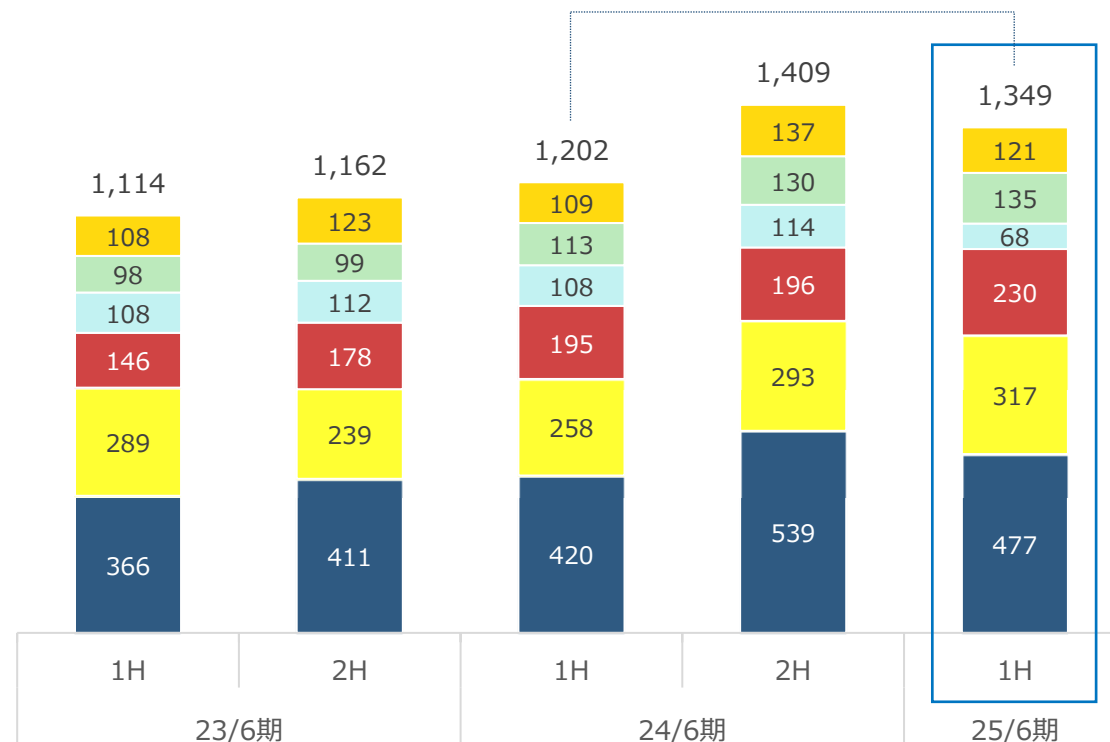


売上高

【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ 材料
■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他

+147億円

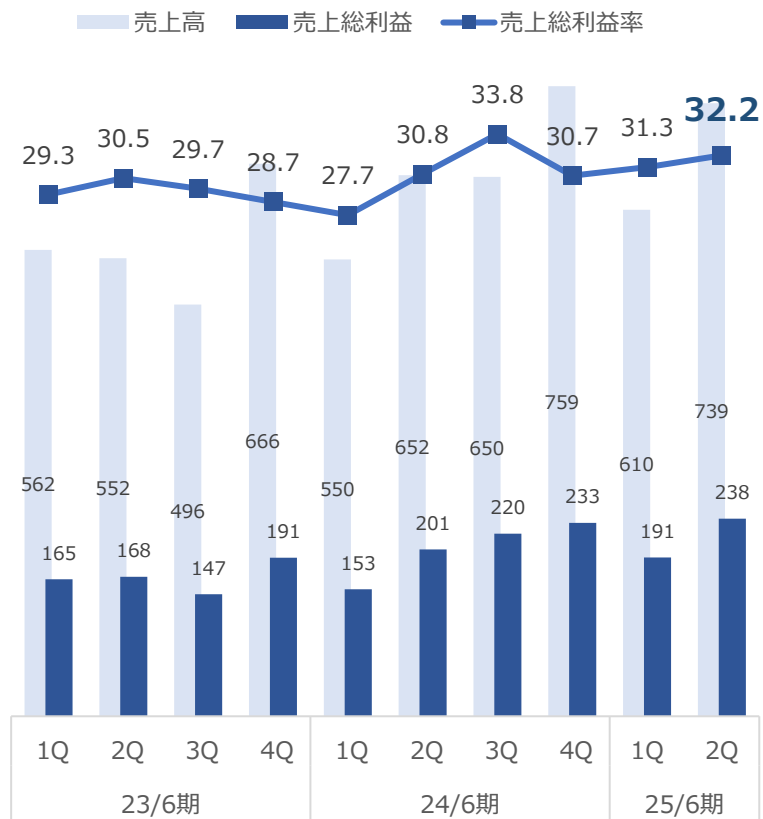


≫ **【受注高】 前1H比 ▲176億円：パワーデバイス・バッテリー等の反動減で減少**

≫ **【売上高】 前1H比 +147億円：売上計上が着実に進み、総じて各品目毎に増加**

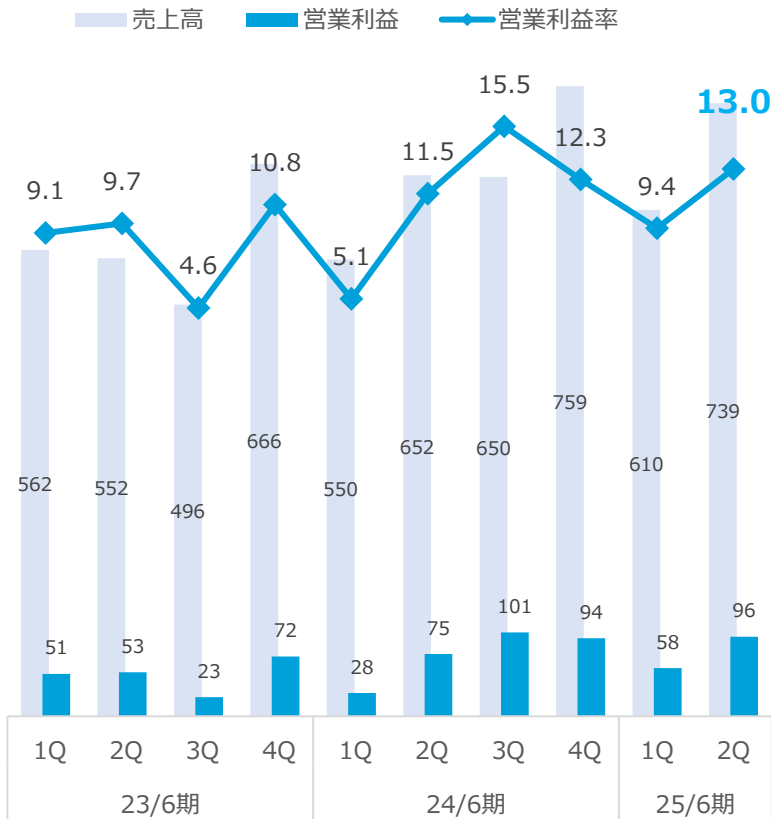
売上総利益率

【単位：億円、%】



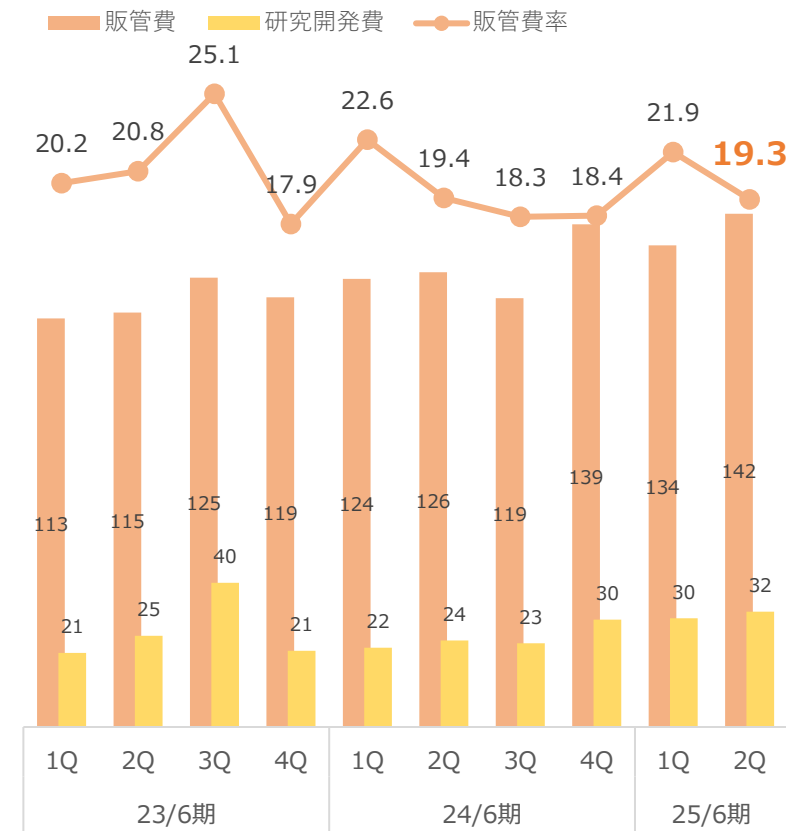
営業利益率

【単位：億円、%】



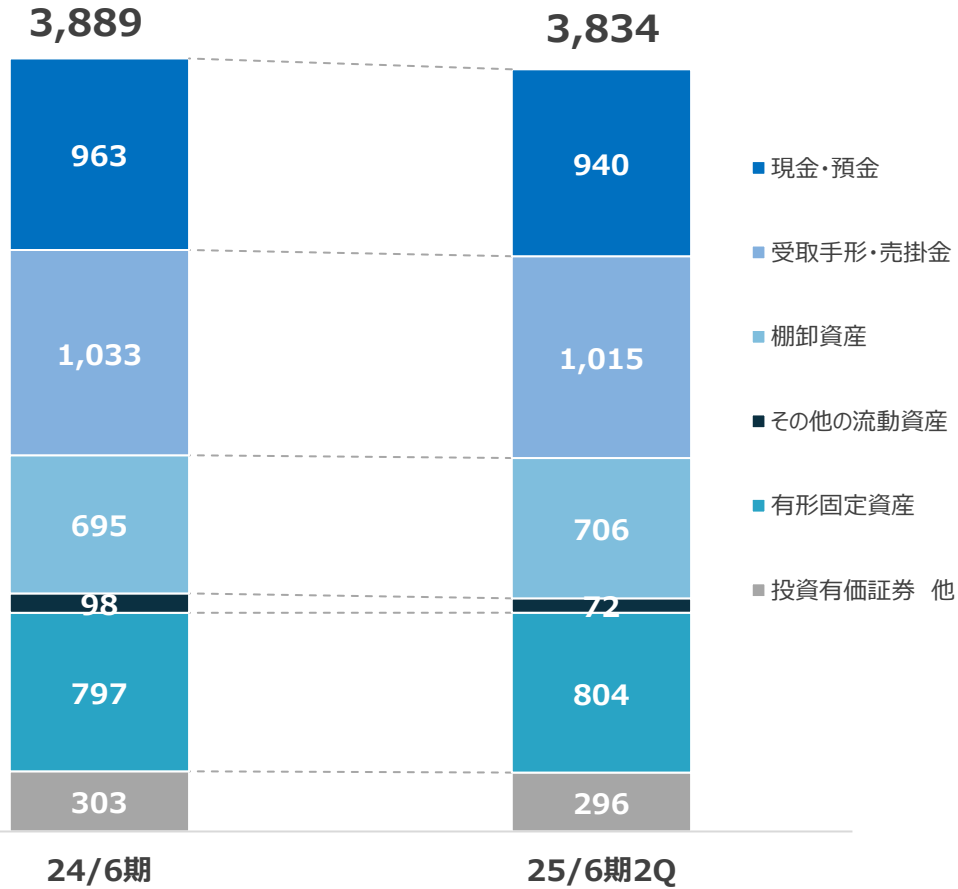
販管費率

【単位：億円、%】

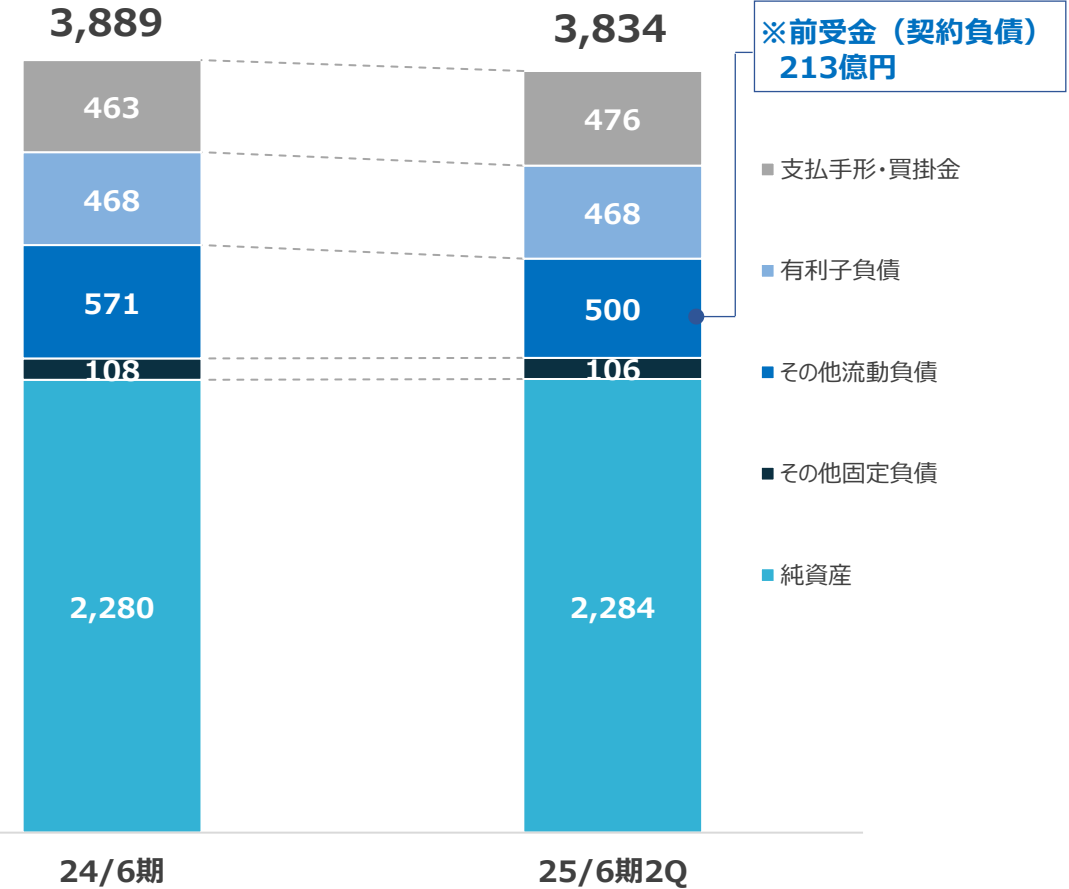


- 売上総利益率**：1Q比増収効果に加え、利益率の高い半導体電子・コンポーネントの売上高構成比は50%超を継続し、利益率のベースは着実に上昇
- 営業利益率**：増収効果等で1Q比3.6pt改善

資産 【単位：億円】



負債・純資産 【単位：億円】



【単位：億円】	24/6期		25/6期			
	通期実績	上期実績	下期予想	通期予想	前年同期比	
					増減額	増減率
受注高	2,582	1,164	1,436	前回※ 2,700	+118	+5%
				今回 2,600		
売上高	2,611	1,349	1,401	2,750	+139	+5%
営業利益	298	153	192	345	+47	+16%
率	11.4%	11.4%	13.7%	12.5%	+1.1pt	-
経常利益	298	161	189	350	+52	+18%
率	11.4%	11.9%	13.5%	12.7%	+1.3pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	202	104	126	230	+28	+14%
率	7.7%	7.7%	9.0%	8.4%	+0.6pt	-
1株あたり配当金（円）	144			164	+20	

半導体電子部品
・パワーデバイス ▲60

ディスプレイ・エネルギー
・バッテリー ▲20

一般産業
・高機能磁石製造装置等 ▲20

※2024/8/13公表値

- 受注高：EV需要鈍化等を反映し、受注高見込みを2,600億円に見直し
- 売上高・各利益(率)：受注残高(2Q末1,255億円)の寄与等もあり、業績予想は据え置き

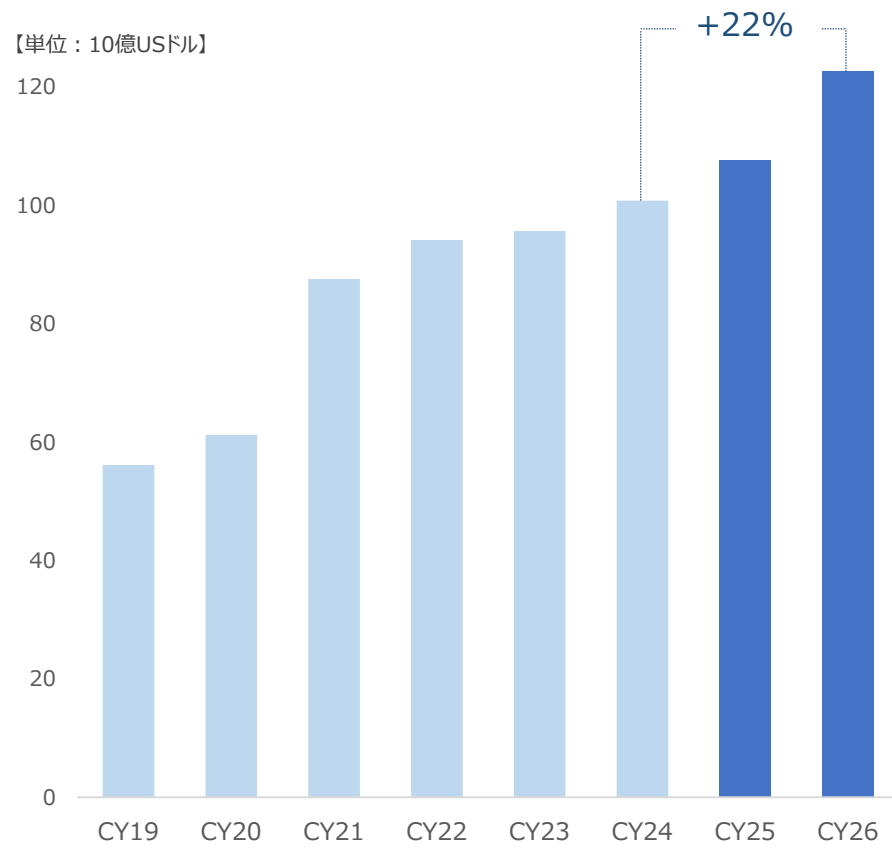


事業環境と今後の展開

品目	市場環境・投資動向	CY25	CY26
半導体 ロジック・メモリ	<ul style="list-style-type: none"> DRAM：生成AI需要拡大により投資加速 NAND：在庫調整が進展し投資再開 先端ロジック：次世代ノードに向けた投資本格化 		
各種電子デバイス	<ul style="list-style-type: none"> 生成AI需要拡大により先端パッケージングビジネス活発化 技術革新・増産投資継続 		
パワーデバイス	<ul style="list-style-type: none"> 足元はEV需要鈍化により投資減速も中長期に成長 		
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> ITパネル用OLED（G8.7）投資活発化 LCD、OLED（G6）高精細化に向けた設備追加・改造案件寄与 		
バッテリー関連	<ul style="list-style-type: none"> 次世代バッテリーの車載への採用タイミングが遅延傾向も中長期的に成長 		
コンポーネント・一般産業・ マテリアル・その他	<ul style="list-style-type: none"> 半導体関連投資の回復等で安定基盤ビジネスとして堅調に推移 AIサーバー冷却システム等、新規用途のリークテスト装置拡大期待 先端デバイス等の研究開発活発化に伴う表面分析装置好調 		

» 市場環境・投資動向トレンドを確実に捉え、全体の受注拡大を目指す

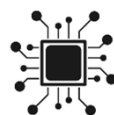
半導体製造装置投資予測



出所：SEMI



AI半導体需要の増加に伴う生産能力拡大



小型化、高速化、省エネを実現するための最先端技術と新しいデバイス構造導入による技術革新

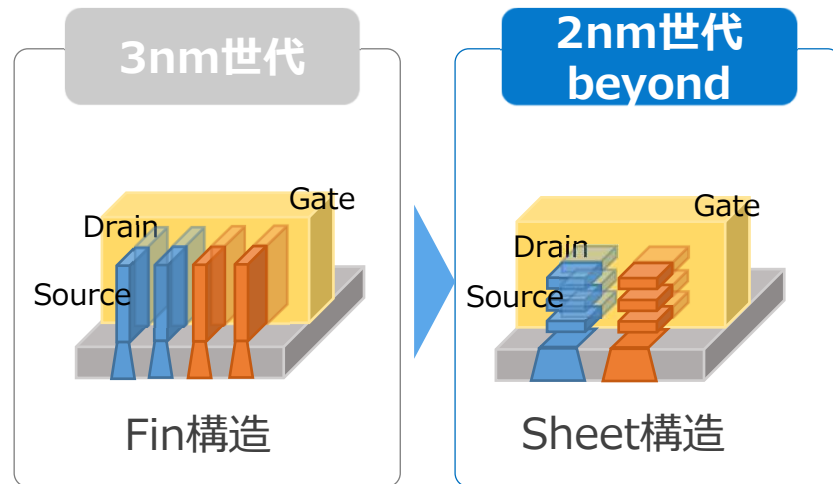


地域サプライチェーン構築のための投資拡大



中長期的成長期待

ロジック・デバイス構造の変化



技術革新（微細化）に伴い、 先端ロジックのビジネス機会拡大

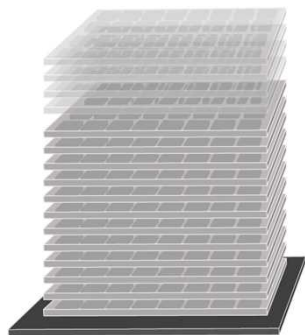
- MHM（メタル・ハード・マスク）適用拡大
 - ・ 5nm・3nmプロセスの拡張
 - ・ EUV露光に加え、DUV露光でも適用拡大
 - ・ MHMの金属材料であるTiNを電極材料として適用

- 2nm世代進展に伴い、Fin構造からSheet構造へ移行
 - ・ 拡散工程のための新Hardmaskの拡大期待
 - ・ 裏面配線への適応

- 他金属工程等、重要顧客との共同開発によるPOR獲得件数拡大（セカンドベンダー期待）

先端メモリ

High Bandwidth Memory



先端パッケージング

Chip on Interposer on Substrate

Now



Fanout比
工程数：1.5倍



3D integrated circuit

Future



Fanout比
工程数：1.5倍 + α

AI半導体需要増加による 生産能力拡大・技術革新進展で成長

先端メモリ

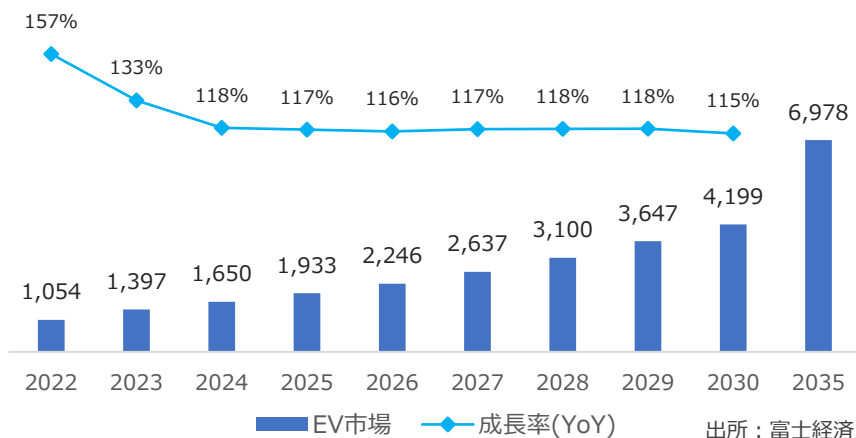
- HBM需要拡大に伴う、従来DRAM（DDR5）の投資拡大
- TiN MHM適用によるDRAM微細化進展
- 次世代NAND向け投資活発化
- 他金属工程等、重要顧客との共同開発によるPOR獲得件数拡大（セカンドベンダー期待）

先端パッケージング

- インターポーザ用デスカム処理装置の投資活発化
- 次世代先端パッケージング向けスパッタリング装置、デスカム・デスマリア処理装置、プラズマダイシング等の開発継続

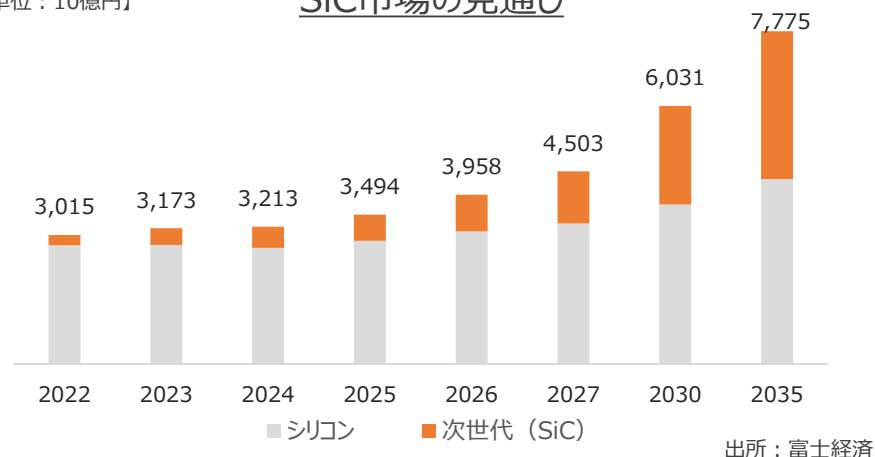
【単位：万台】

EV市場の見通し



【単位：10億円】

SiC市場の見通し



EV市場回復に伴い SiC市場は大きく成長



ウェハーサイズアップ（6→8inch）に伴い、
日本・中国で販売拡大



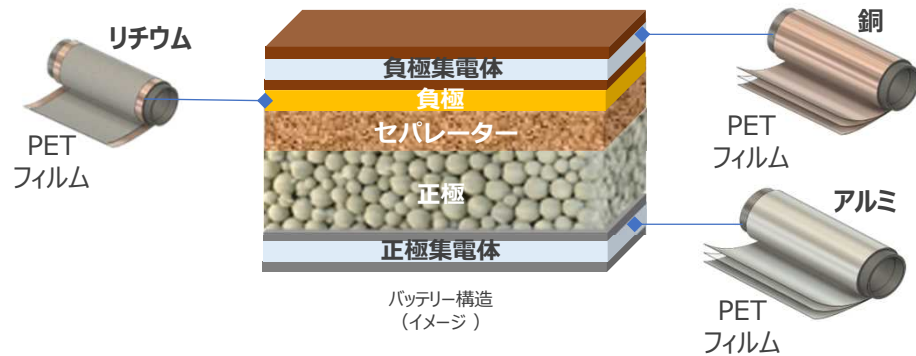
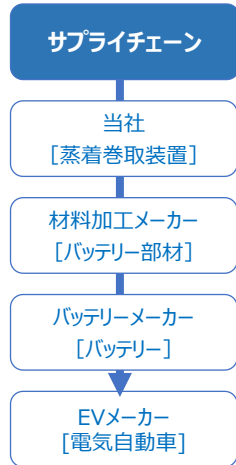
高いシェアを有する日本：スパッタリング装置、
中国：イオン注入装置をクロスセルで拡販



- プレーナ→トレンチ構造切替を機にSiC化合物エッチング装置を拡販
- GaN化合物スパッタリング装置の市場投入→将来の需要を取り込む

両面蒸着膜集電体の効果

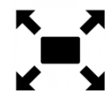
- ① 安全性向上
- ② 小型軽量化
- ③ 部材コスト低減
- ④ GHG低減



安全性向上・小型軽量化実現に向けた アルミ両面蒸着膜技術の普及により成長



現行モデルの生産安定化に向けた顧客フォローの継続による改善



生産性向上を目指すフィルム幅広化モデルの量産技術開発継続



- ・ 負極集電体の置き換えを目指す銅厚膜成膜の開発継続
- ・ 次世代電池負極（リチウム）の開発継続

半導体向け成膜装置の新モデル受注開始

従来モデルの特長を継承しつつ、データ収集・解析能力と拡張性を強化した次世代プラットフォーム「ENTRON-EXX」の受注開始

- 待機状態での消費電力**20%**削減
- クリーンルーム内での設置床面積**最大10%**削減
- リアルタイムでのデータ解析により生産性向上
- 迅速なモジュール追加が可能な設計により変化するニーズに柔軟に対応 ⇒移設改造納期**50%**削減

真空技術を通じて半導体産業の発展に貢献



Silicon Austria Labs GmbH (SAL) と連携 薄膜ニオブ酸リチウム (TFLN) の量産製造プロセス 向けプラズマエッチング技術を開発

TFLNは広帯域、低損失、高効率の特性を持つ次世代光デバイス材料であり、データ通信容量の需要に対応

SALは、光デバイス内部の光導波路を形成するためのプラズマエッチング装置「NLD-5700」を導入し、200mmプラットフォームでの材料統合とスケラビリティの向上を目指す

この協力により、技術革新を推進し、マイクロエレクトロニクスエコシステム全体に貢献



Silicon Austria Labs GmbH (SAL) は、マイクロシステム、センサーシステム、インテリジェント無線システム、パワーエレクトロニクス、組込みシステム分野で、一貫した研究成果と経済的影響を生み出すことで、アイデアを革新へとつなげています。





ULVAC